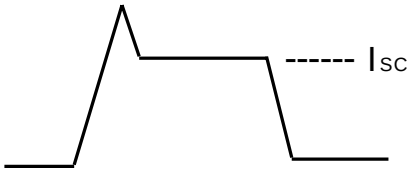
富士 IGBT モジュール　U シリーズ

短絡電流と V_{GE} 特性　1200V

測定サンプル: 2MBI150UA-120、2MBI200UB-120、2MBI300UD-120

条件:
- V_{DC}=600V
- +V_{GE}=8、10、13、15、18V
- –V_{GE}=15V
- Tj=125°C
- R_G (推奨値)= 2.2Ω (2MBI150UA-120)
  3.0Ω (2MBI200UB-120)
  1.1Ω (2MBI300UD-120)

結果:
- V_{GE} - I_{SC} 特性 ……図 1
- I_{SC} の定義: 短絡時の飽和電流



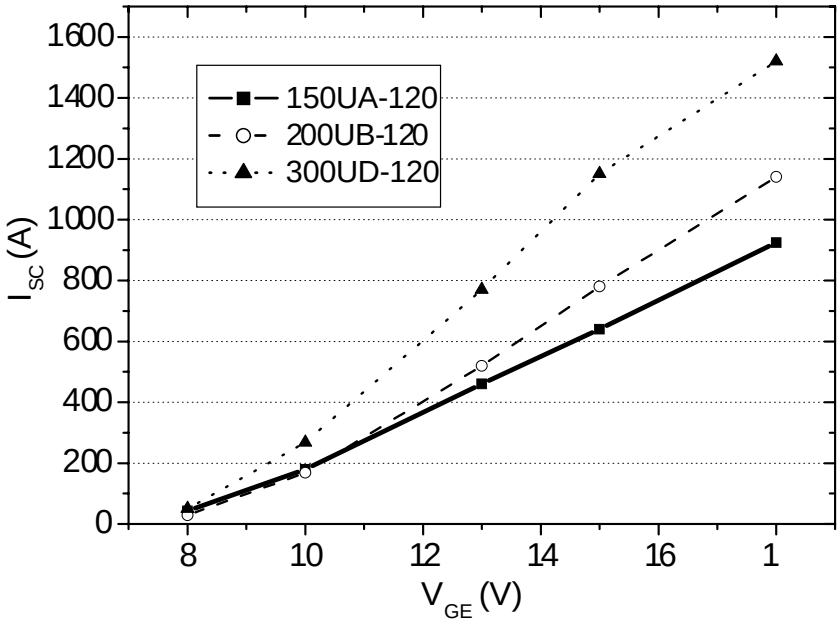


図 1　V_{GE} - I_{SC} 特性

電流電圧波形: 2MBI150UA-120 ……図 2～図 6
2MBI200UB-120 ……図 7～図 11
2MBI300UD-120 ……図 12～図 16

2MBI150UA-120

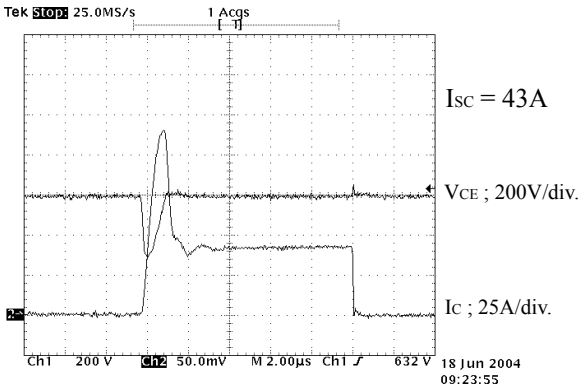


図 2　V_{GE}=8V

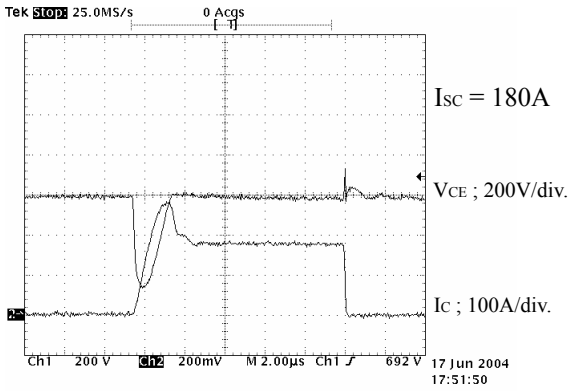


図 3　V_{GE}=10V

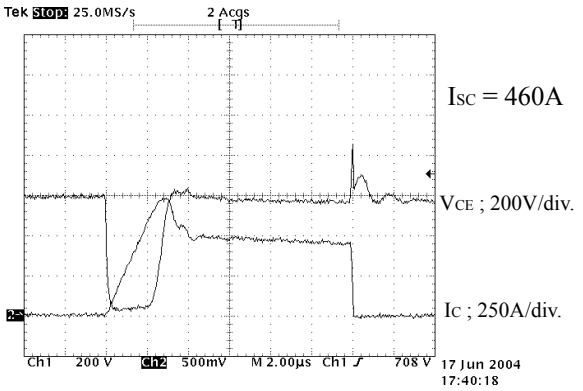


図 4　V_{GE}=13V

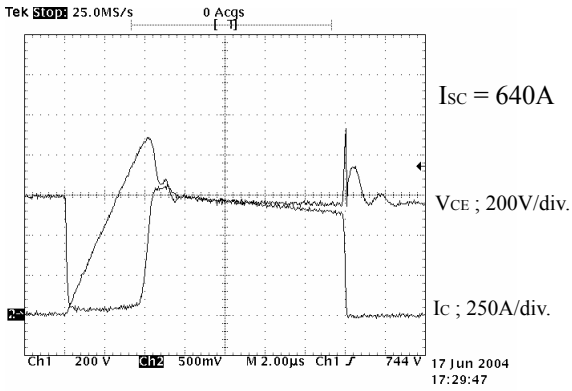


図 5　V_{GE}=15V

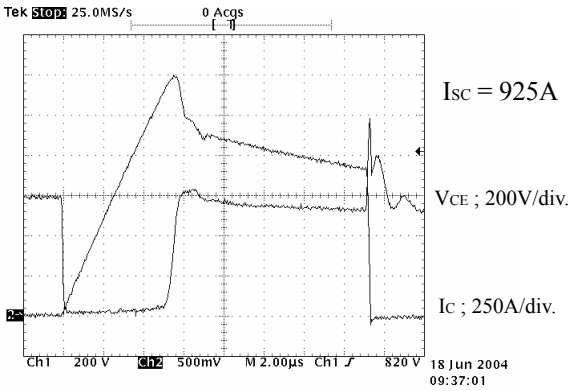


図 6　V_{GE}=18V

2MBI200UB-120

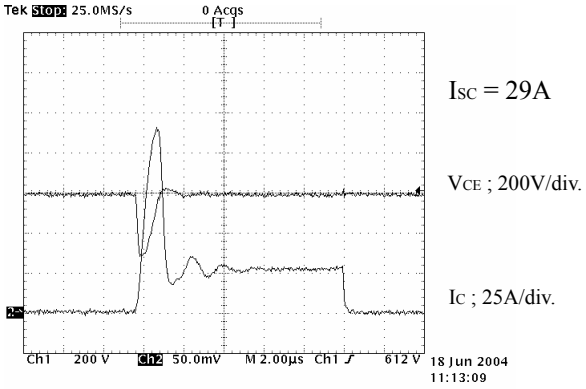


図 7　V_{GE}=8V

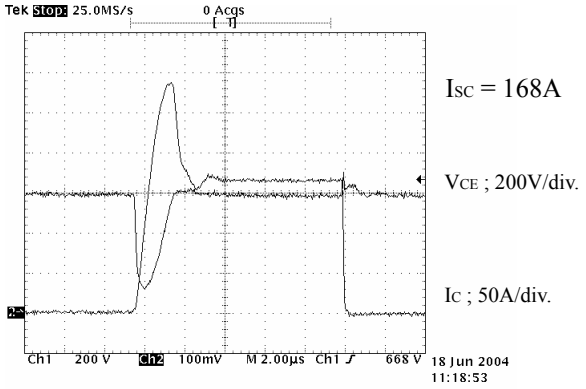


図 8　V_{GE}=10V

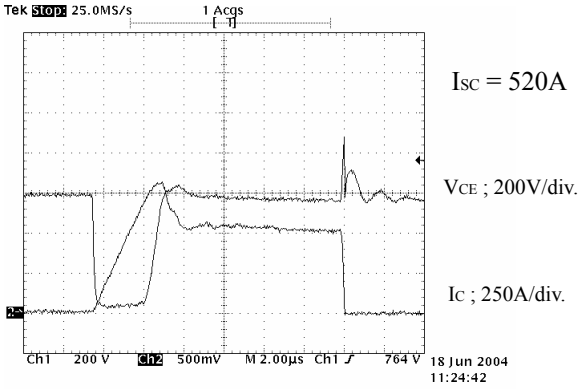


図 9　V_{GE}=13V

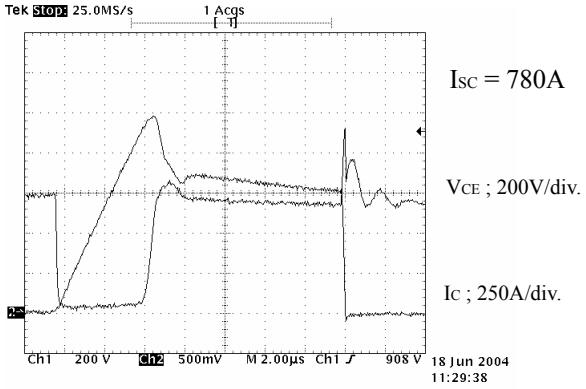


図 10　V_{GE}=15V

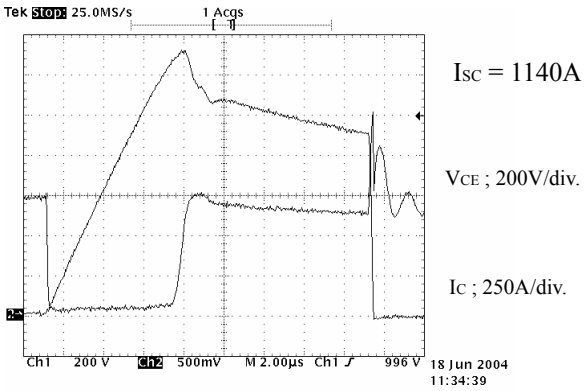


図 11　V_{GE}=18V

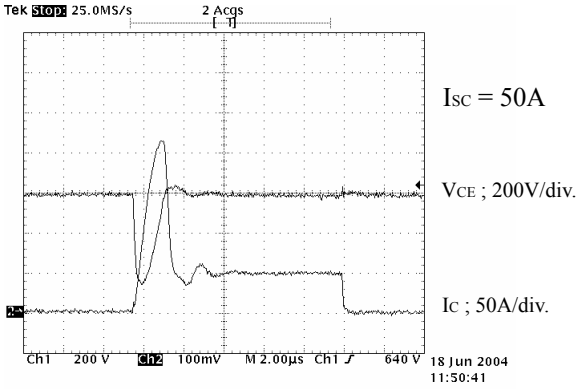


図 12　V_{GE}=8V

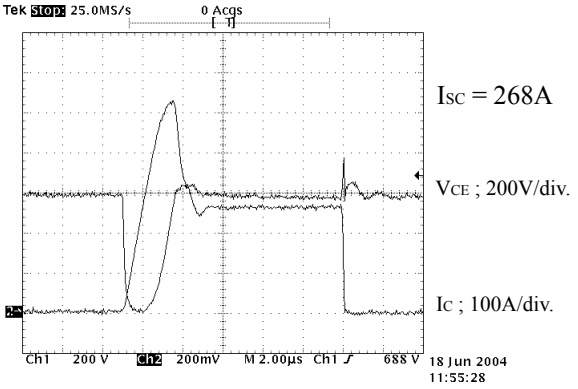


図 13　V_{GE}=10V

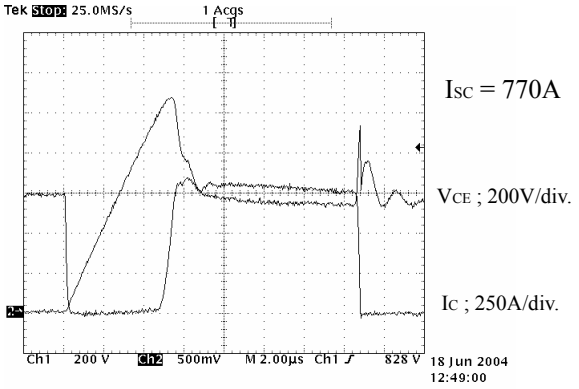


図 14　V_{GE}=13V

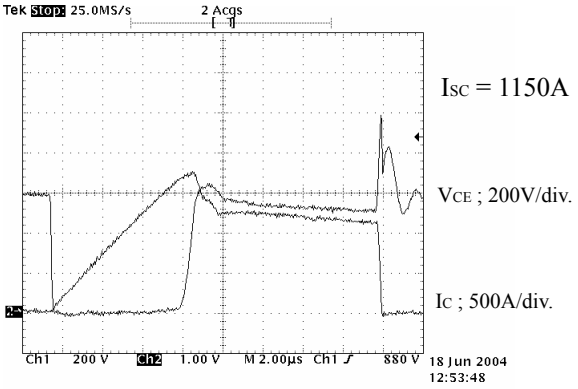


図 15　V_{GE}=15V

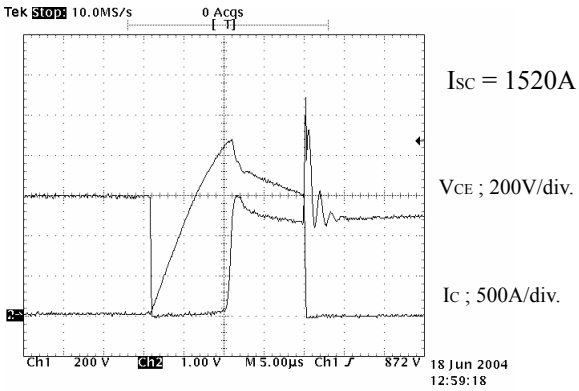


図 16　V_{GE}=18V